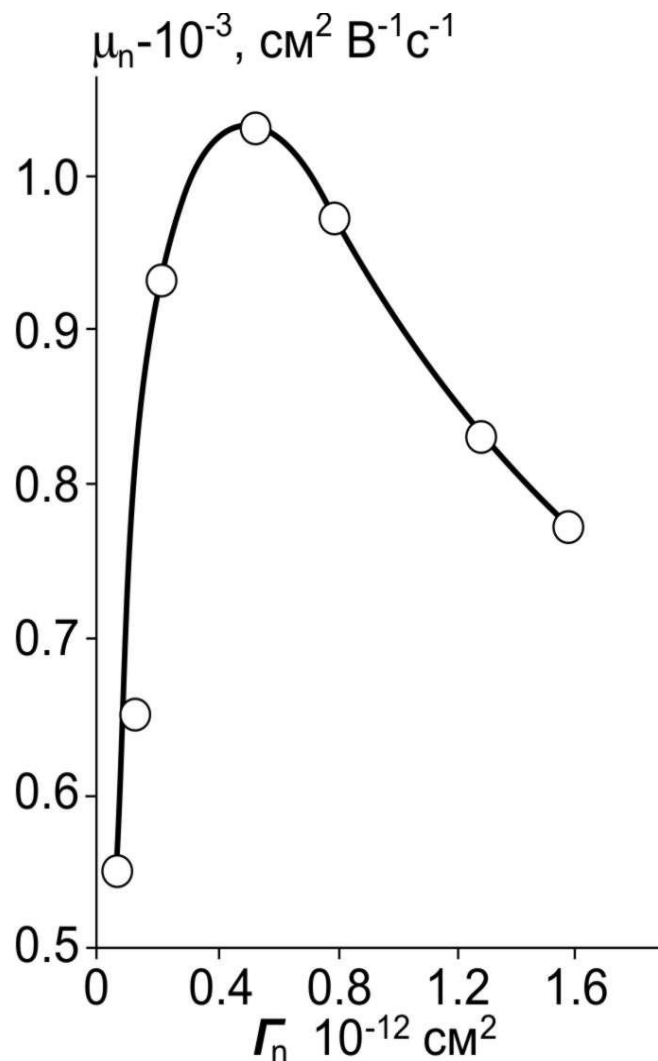


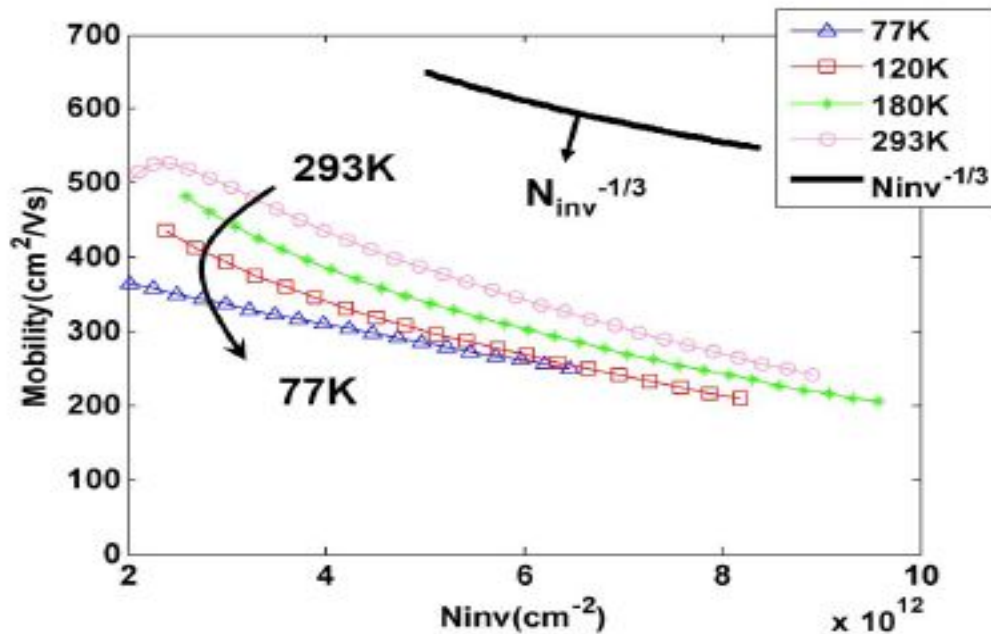
IEEE El.Dev.v.56N4, apr.2009

ИФП 1976 год

ИФП :Микроэл.т.5,в.4; 1976 г  
Thin Sol.Films,58(1979)



IEEE El.Dev.v.56,N4,Apr.2009



Цитата из статьи:

**“We reported the highest electron mobility ( $\mu_n$ ) for Ge NMOS in the literature”**

Основные идеи А.В.Ржанова, положенные в основу формирования совершенной границы раздела, и выполненные под его руководством работы по созданию МДП – транзистора на основе германия привели к получению прибора, **характеристики которого не могут превзойти даже через 30 лет!**

**Они до сих пор являются лучшими в мире!**





*Лаборатория поверхностных явлений в полупроводниках, январь 1963 г.*

П. Б. ... .. 1963 ... .. Б. ... ..





Лаборатория поверхностных явлений 1967 года



Учёный сосет ИФП СО РАН в 1970 году

Большое спасибо всем , кто пришёл на этот  
учёный совет, посвящённый памяти  
организатора и первого директора нашего  
института  
академика РАН

**Анатолия Васильевича  
Ржанова**